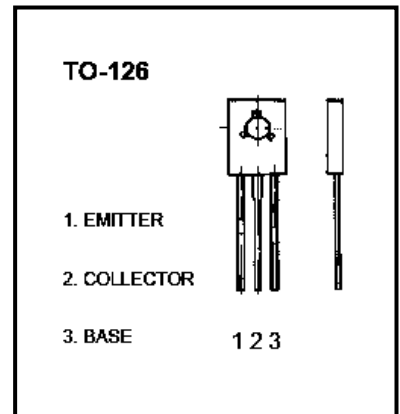


深圳市晶泰源电子有限公司

2SD882 NPN 晶体管

- 1、 封装形式：TO-126
- 2、 互补型号：2SB772
- 3、 极限参数(绝对最大额定值 $T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数名称	符号	参数值	单位
集电极-基极电压	BV_{CBO}	40	V
集电极-发射极电压	BV_{CEO}	25	V
集电极最大电流	I_{CM}	2	A
耗散功率	P_D	1.5	W
贮存结温	T_j, T_{stg}	$-55 \sim +150$	$^{\circ}\text{C}$



4、电参数特性 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数名称	符号	测试条件	参数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
集电极-基极电压	BV_{CBO}	$I_C=100\mu\text{A}, I_E=0$	40			V
集电极-发射极电压	BV_{CEO}	$I_C=10\text{mA}, I_B=0$	25			V
发射极-基极电压	BV_{EBO}	$I_E=100\mu\text{A}, I_C=0$	6			V
集电极-基极漏电流	I_{CBO}	$V_{CB}=40\text{V}, I_E=0$			1	μA
集电极-发射极漏电流	I_{CEO}	$V_{CE}=25\text{V}, I_B=0$			10	μA
发射极-基极漏电流	I_{EBO}	$V_{EB}=6\text{V}, I_C=0$			1	μA
直流放大倍数	$H_{FE(1)}$	$V_{CE}=2\text{V}, I_C=1\text{A}$	60		400	
	$H_{FE(2)}$	$V_{CE}=2\text{V}, I_C=100\text{mA}$	32			
饱和压降	V_{CESAT}	$I_C=2\text{A}, I_B=0.2\text{A}$			0.5	V
正向压降	V_{BESAT}	$I_C=2\text{A}, I_B=0.2\text{A}$			2	V
特征频率	f_T	$V_{CE}=5\text{V}, I_B=100\text{mA}$	50			MHz